



МИКРОСХЕМА ТИПА  
КР1816ВЕ51

70

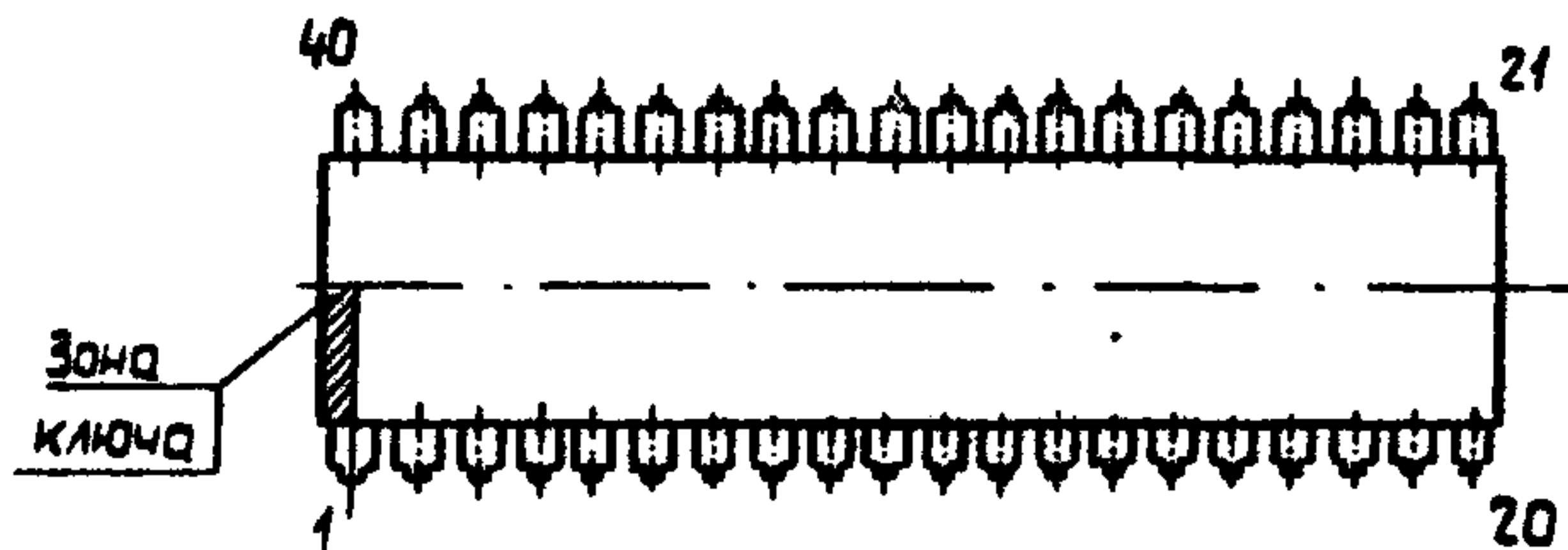
Э Т И К Е Т К А

Микросхема интегральная типа КР1816ВЕ51.

Функциональное назначение: однокристалльная микро-ЭВМ.

Климатическое исполнение: УХЛ.

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ВЫВОДОВ



• Масса не более 8 г.

ТАБЛИЦА НАЗНАЧЕНИЯ ВЫВОДОВ

Номер вывода	Наименование		Обозначение	Тип вывода
I-8	Порт I	Адрес ПЗУ-A (0-7)	PI.0-PI.7	Вход/ выход
9	Сброс	Резервное питание ОЗУ - $\overline{V_{CCS}}$	SR	Вход
10	Порт 3	Последовательные данные приемника - R x D	P3.0-P3.7	Вход/ выход
11		Последовательные данные передатчика - T x D		
12		Прерывание 0 - $\overline{INT0}$		
13		Прерывание I - $\overline{INTI}$		
14		Таймер/счетчик 0-TO		
15		Таймер/счетчик I-TI		
16		Запись - $\overline{WR}$		
17		Чтение - $\overline{RD}$		
18	Выводы для подключения кварцевого резонатора	Внешняя синхронизация	BQ2	Вход
19		-	BQ1	
20	Общий вывод		0V	-
21-28	Порт 2	Адрес -A (8-15)	P2.0-P2.7	Вход/ выход
29	$\overline{\text{Разрешение про-}} \overline{\text{граммной памяти}}$	$\overline{\text{Установка режима}} \overline{\text{чтения ПЗУ}}$	$\overline{\text{PME}}$	
30	Разрешение фикса- ции адреса	Установка режима чтения ПЗУ	ALE	
31	$\overline{\text{Блокировка работы с внутренней памятью}}$		$\overline{\text{DEMA}}$	Вход
32-39	Порт 0	Адрес/данные-A/D (7-0)	PO.7-PO.0	Вход/ выход
40	Вывод питания от источника напряжения		$V_{CC}$	5V

**ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ В ДИАПАЗОНЕ  
ТЕМПЕРАТУР ОТ МИНУС 10°C ДО 70°C**

Наименование параметра, единица измерения режим измерения	Буквенное обозначение	Н о р м а	
		не менее	не более
Выходное напряжение высокого уровня сигналов P1 (0-7), P2 (0-7), P3 (0-7), В ( $I_{OH} = -0,08$ мА)	$U_{OH}$	2,4	-
Выходное напряжение высокого уровня сигналов P0 (7-0), ALE, PME, В ( $I_{OH} = -0,4$ мА)	$U_{OHI}$		
Выходное напряжение низкого уровня сигналов P1 (0-7), P2(0-7), P3(0-7), В ( $I_{OL} = 1,6$ мА)	$U_{OI}$	-	0,45
Выходное напряжение низкого уровня сигналов P0 (7-0), ALE, PME, В ( $I_{OL} = 3,2$ мА)	$U_{OLI}$		
Входной ток высокого уровня сигнала SR, мкА ( $V_I \leq U_{CC} - 1,5$ В)	$I_{IH}$		500
Входной ток низкого уровня сигналов P1 (0-7), P2(0-7), P3(0-7), мкА ( $V_I = 0,45$ В)	$I_{IL}$		/-800/
Входной ток низкого уровня сигнала BQ2, мА ( $V_{BQ1} = 0,0$ В, $V_I = 0,45$ В)	$I_{ILI}$		/-2,5/
Выходной ток в состоянии "Выключено", мкА $0,45$ В $\leq V_I \leq U_{CC}$ Ток утечки сигнала $\overline{DEMA}$ , мкА $0,45$ В $\leq V_I \leq U_{CC}$	$I_{OZ}$ $I_L$		/±10/
Ток потребления, мА.	$I_{CC}$		150 <sup>ж</sup>
Ток потребления в режиме резервного пи- тания, мА ( $V_{CC} = 0,0$ В; $V_{CCS} = 5,0$ В)	$I_{CCS}$		125 <sup>жж</sup> 10

В диапазоне температур:  
ж от минус 10°C до 0°C  
жж от 0°C до 70°C

Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. микросхем:

—  
золото —

18,224г

Цветных металлов не содержится.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ ИЮН 1991

Микросхемы типа КР1816ВЕ51 соответствуют техническим условиям  
ОК0.348.839ТУ, ОК0.348.839-05ТУ.

ШТАМП

ОТК

ОТК487

Перепроверка произведена \_\_\_\_\_

дата

ШТАМП ОТК

УПАКОВЩИК 6